

Félix Palumbo recibió el título de licenciado en Cs. Físicas (2000) y el doctorado (2005) ambos en Cs. Físicas de la UBA, Argentina. Desde 2005 es miembro del CONICET como investigador adjunto. Desde 1997 al 2005 fue miembro del laboratorio de física de dispositivos y microelectrónica en la FI-UBA trabajando en efectos de la radiación y fiabilidad en sistemas MOS. Desde 2001 al 2002 fue miembro del grupo de investigación y desarrollo de Tower Semiconductor en Migdal Haemek Israel, investigando en fiabilidad de óxidos ultra delgados y memorias flash. Desde 2003 realiza visitas frecuentes como científico invitado al centro IMM-CNR en Catania Italia (2002-2006-2011), a la Universidad Autónoma de Barcelona en España (2009), y al centro MINATEC en Grenoble, Francia (2010).

Es investigador asociado del Internacional Centre of Theoretical Physics (ICTP), Trieste Italia, revisor del *Journal of Applied Physics*, *da la Electrochemical Society* y director de subsidios de investigación en la SeCyT Argentina, y del Ministero degli Affari Esteri en Italia.

Actualmente supervisa tesis de Doctorado en el campo de fiabilidad de dispositivos CMOS, efectos de la radiación en MOSFET y MEMs.

Respecto de la actividad docente, es profesor investigador de la Universidad Tecnológica Nacional en Buenos Aires, en la cátedra de dispositivos electrónicos.

Su campo actual de investigación involucra la fiabilidad de óxidos ultra delgados, efectos de ruptura reversible, metal gates, dieléctricos high-k y efectos de la radiación en dispositivos semiconductores. Es autor o co-autor de un artículo review y más de veinte publicaciones en revistas científicas y técnicas internacionales con referato.